



中华人民共和国国家标准

GB/T 26069—2010

硅退火片规范

Specification for silicon annealed wafers

2011-01-10 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2)负责归口。

本标准起草单位:万向硅峰电子股份有限公司、有研半导体材料股份公司、宁波立立电子股份有限公司和杭州海纳半导体有限公司共同负责起草。

本标准主要起草人:楼春兰、孙燕、朱兴萍、宫龙飞、王飞尧、黄笑容、方强、汪成生、程国庆。

硅退火片规范

1 范围

本标准规定了半导体器件和集成电路制造用硅退火抛光片的要求、试验方法、检验规则等。
本标准适用于线宽 180 nm、130 nm 和 90 nm 工艺退火硅片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法
- GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法
- GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法
- GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 4058 硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法
- GB/T 6616 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法
- GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法
- GB/T 6620 硅片翘曲度非接触式测试方法
- GB/T 6621 硅抛光片表面平整度测试方法
- GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法
- GB/T 11073 硅片径向电阻率变化的测量方法
- GB/T 13387 硅及其他电子材料晶片参考面长度测量方法
- GB/T 13388 硅片参考面结晶学取向 X 射线测试方法
- GB/T 14140 硅片直径测量方法
- GB/T 14144 硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法
- GB/T 14264 半导体材料术语
- GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法
- GB/T 24578 硅片表面金属沾污的全反射 X 光荧光光谱测试方法
- YS/T 26 硅片边缘轮廓检验方法

3 术语和定义

GB/T 14264 中界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 产品分类

本标准将硅退火抛光片按线宽分为 180 nm、线宽 130 nm 和线宽 90 nm 三类。